

94-0008

Изобретение относится к полупроводниковой технологии и может быть использовано для получения эпитаксиальных слоев фосфида индия, выращенных хлоридным способом с воспроизводимыми электрофизическими параметрами. Для повышения качества и воспроизводимости электрофизических параметров эпитаксиальных слоев в процессе выращивания эпитаксиальных слоев АШВV в хлоридной системе, включающем подготовку оснастки, химическое травление, продувку реактора водородом, термостатирование хлорида, нагрев источника и подложек, химическое травление подложек, выращивание слоев, проводят повторное газовое травление выращенного слоя с последующим его ростом .

Технический результат предложенного изобретения заключается в повышении качества и воспроизводимости электрофизических параметров эпитаксиальных слоев.